

Transistor Mosfet 2N7000 tipoN

Codigo: **113177**



Descripción

Este MOSFET de pequeña señal es fabricado con tecnología DMOS de alta densidad patentada por ON Semiconductor. Ha sido diseñado para minimizar la resistencia de encendido, a la vez que proporciona un buen rendimiento en aplicaciones de conmutación de alta velocidad. Se puede usar en la mayoría de las aplicaciones que requieran hasta 400 mA y puede suministrar corrientes pico de hasta 2 A. Este MOSFET es adecuado para aplicaciones de bajo voltaje y baja corriente.

- Serie: 2N7000
- Encapsulado: TO-92 - 3
- Tipo: Canal N
- Vds: 60 V
- Id: 200 mA
- Rds de encendido: 1.2 Ohms
- Vgs: 20 V
- Temperatura de operación: -55°C a 150 °C
- Disipación de potencia: 400 mW